



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202738941 U

(45) 授权公告日 2013. 02. 20

(21) 申请号 201220284856. 2

(22) 申请日 2012. 06. 17

(73) 专利权人 庄桐

地址 362399 福建省泉州市南安溪美新华街
199 号 2 幢 502 室

(72) 发明人 庄桐

(51) Int. Cl.

A43B 13/14 (2006. 01)

A61H 39/04 (2006. 01)

A61N 2/08 (2006. 01)

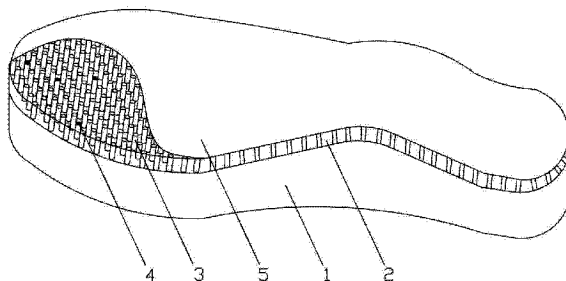
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

(54) 实用新型名称

一种按摩鞋底

(57) 摘要

一种按摩鞋底,包括有下鞋底层及按摩层,该下鞋底层上表面全面贴合足底,其前掌和后跟部位为平整状,中间部位是与足心部位生理曲线相适配的圆滑隆起,该按摩层为复合于下鞋底层上平行于下鞋底层上表面设置的凸起的按摩颗粒,该按摩层上与足底穴位相对应位置的按摩颗粒顶端贴有磁铁片。本实用新型全面贴合足底,使人行走时足底与鞋底全面接触,足底受力均匀,足弓得到托扶,足心部位的穴位也可得到充分按摩,同时,与足底穴位相对应位置的按摩颗粒顶端设置的磁铁片可通过磁场刺激足底穴位,促进血液循环,减轻疲劳,可有效对足底进行按摩,对人体有保健作用。



1. 一种按摩鞋底,包括有下鞋底层及按摩层,其特征在于:该下鞋底层上表面全面贴合足底,其前掌和后跟部位为平整状,中间部位是与足心部位生理曲线相适配的圆滑隆起,该按摩层为复合于下鞋底层上平行于下鞋底层上表面设置的凸起的按摩颗粒,该按摩层上与足底穴位相对应位置的按摩颗粒顶端贴有磁铁片。

2. 如权利要求 1 所述的一种按摩鞋底,其特征在于:所述按摩颗粒与下鞋底层为一体成型。

3. 如权利要求 1 所述的一种按摩鞋底,其特征在于:所述按摩层表面还设有织布层。

一种按摩鞋底

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种按摩鞋底,特别是一种可有效对足底进行按摩的按摩鞋底。

背景技术

[0002] 目前,现有的按摩鞋底一般均是平板型,在鞋底上表面设置有按摩颗粒,这种鞋底和足底的接触部位仅限于足前掌和足后跟,而足心部位与鞋底不接触,这使得整个足底受力不均匀,且足心部位的穴位得不到按摩,同时,采用按摩颗粒对足底的穴位进行按摩的按摩效果不理想,随着科技的发展和人们对自身健康的日益重视,此种结构的按摩鞋底往往不能满足人们的需求。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的主要目的是克服现有技术的缺点,提供一种可有效对足底进行按摩的按摩鞋底。

[0004] 本实用新型采用如下技术方案:

[0005] 一种按摩鞋底,包括有下鞋底层及按摩层,该下鞋底层上表面全面贴合足底,其前掌和后跟部位为平整状,中间部位是与足心部位生理曲线相适配的圆滑隆起,该按摩层为复合于下鞋底层上平行于下鞋底层上表面设置的凸起的按摩颗粒,该按摩层上与足底穴位相对应位置的按摩颗粒顶端贴有磁铁片。

[0006] 所述按摩颗粒与下鞋底层为一体成型。

[0007] 所述按摩层表面还设有织布层。

[0008] 由上述对本实用新型的描述可知,与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:全面贴合足底,使人行走时足底与鞋底全面接触,足底受力均匀,足弓得到托扶,足心部位的穴位也可得到充分按摩,同时,与足底穴位相对应位置的按摩颗粒顶端设置的磁铁片可通过磁场刺激足底穴位,促进血液循环,减轻疲劳,可有效对足底进行按摩,对人体有保健作用。

附图说明

[0009] 图1是本实用新型具体实施方式的局部剖视结构示意图。

[0010] 图2是本实用新型具体实施方式的按摩层的俯视结构示意图。

[0011] 图中:1. 下鞋底层,2. 按摩层,3. 按摩颗粒,4. 磁铁片,5. 织布层。

具体实施方式

[0012] 以下通过具体实施方式对本实用新型作进一步的描述。

[0013] 参照图1和图2,一种按摩鞋底,包括有下鞋底层1及按摩层2,该下鞋底层1上表面全面贴合足底,其前掌和后跟部位为平整状,中间部位是与足心部位生理曲线相适配的圆滑隆起,该按摩层2为复合于下鞋底层1上平行于下鞋底层1上表面设置的凸起的按摩

颗粒 3,该按摩层 2 上与足底穴位相对应位置的按摩颗粒 3 顶端贴有磁铁片 4,该按摩颗粒 3 与下鞋底层 1 为一体成型,该按摩层 2 表面还设有织布层 5。

[0014] 参照图 1 和图 2,本实用新型全面贴合足底,使人行走时足底与鞋底全面接触,足底受力均匀,足弓得到托扶,足心部位的穴位也可得到充分按摩,同时,与足底穴位相对应位置的按摩颗粒 3 顶端设置的磁铁片 4 可通过磁场刺激足底穴位,促进血液循环,减轻疲劳,可有效对足底进行按摩,对人体有保健作用。

[0015] 上述仅为本实用新型的一个具体实施方式,但本实用新型的设计构思并不局限于此,凡利用此构思对本实用新型进行非实质性的改动,均应属于侵犯本实用新型保护范围的行为。

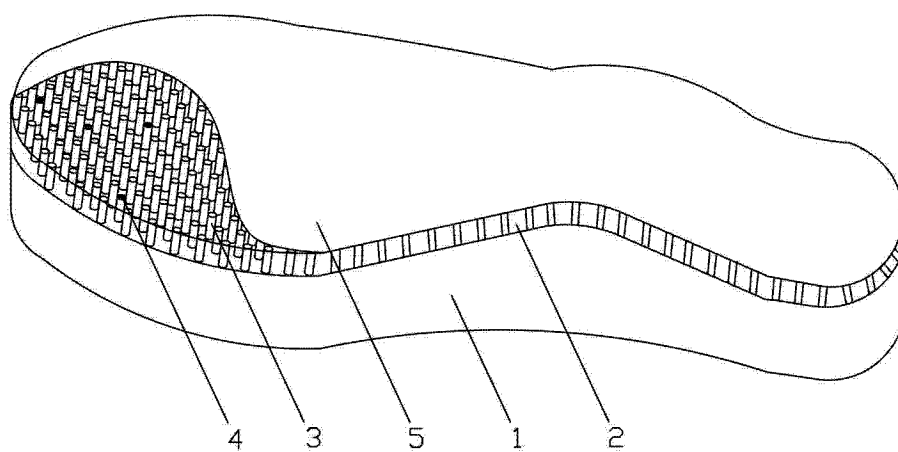


图 1

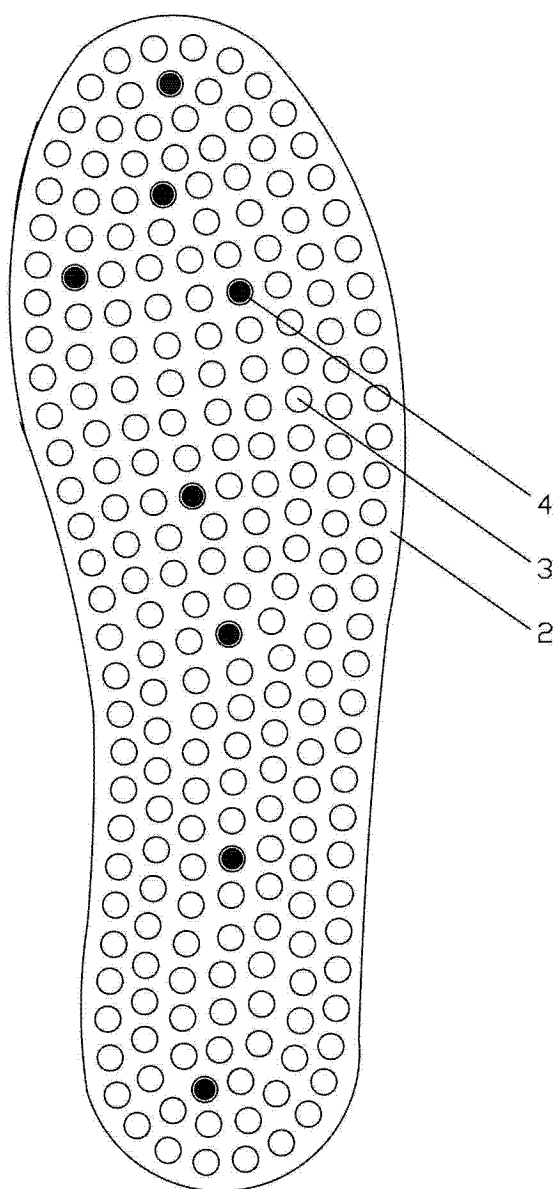


图 2